

s 2020 0093

Invenția se referă la tehnica electronică și poate fi utilizată pentru confecționarea termoelectrozilor pentru generatoare termoelectrice.

Materialul termoelectric anizotrop pe bază de bismut, conform invenției, constă din bismut dopat cu staniu, unde concentrația staniului constituie 0,08% at. Materialul este confecționat în formă de microfir cu diametrul de 150 nm în izolație de sticlă de molibden.

Revendicări: 1